



## 美光就福建省專利訴訟案件之聲明

美國愛達荷州博伊西市 ( 2018 年 7 月 5 日 ) - 美光科技公司 ( NASDAQ 股票代碼 : MU ) 宣布，中國福建省福州市中級人民法院於今日通知美光在中國之兩家子公司，已就聯華電子股份有限公司 ( 簡稱 “ 聯電 ” ) 與福建省晉華集成電路有限公司 ( 簡稱 “ 晉華 ” ) 所提之專利侵權案件，裁定批准初步禁制令。聯電與晉華起訴美光專利侵權案件，實為報復台灣檢察機關針對聯電及其三名員工侵犯美光商業機密所提刑事指控，以及美光就此針對聯電與晉華向美國北加州地方法院提起的民事訴訟。

此初步禁制令限制美光中國兩子公司，在中國製造、銷售或進口 Crucial 及 Ballistix 品牌部分型號之 DRAM 模組與固態硬碟。在此禁制令下，所受影響之產品約占美光年營收 1% 之多，由於目前已進入第四財季，美光預估禁制令對本季營收影響大約為 1%，本季營收預測將維持於 80 億至 84 億美元範圍內。美光將依法遵守該禁制令，同時申請法院重新考慮或中止執行該初步禁制令。

美光法務長暨法律總顧問、資深副總裁 ( senior vice president, legal affairs, general counsel and corporate secretary ) Joel Poppen 先生表示，「美光對於福州市中級人民法院之裁決深表遺憾。美光堅信涉案專利無效，且美光產品並未侵權。福州法院並未給予美光陳述及辯護之機會，即批准此初步禁制令。此舉以及福州法院的其他做法，不符以適宜司法程序進行公平審訊之準則。美光在中國成功經營業務多年，在西安設有重要封測製造基地，亦與中國諸多重要客戶擁有深厚關係，美光將持續積極對抗這種不實的侵權指控，並與客戶及夥伴繼續密切合作」。

聯電與晉華於今年元月在中國福建省控告美光在中國之子公司，宣稱 Crucial 及 Ballistix 品牌部分型號之 DRAM 模組及固態硬碟侵害聯電與晉華在中國的專利權。本案所宣稱之專利原先均由聯電獲得授權。聯電為邏輯 IC 產品半導體代工廠，一直以來欠缺先進 DRAM 與 NAND 快閃記憶體技術。儘管美光並未使用該等專利於旗下 DRAM 與 NAND 技術或產品中，聯電與晉華卻曲解專利內容，並以不實證據誣指美光侵權。美光已將充分的證據遞交至中國國家知識產權局專利複審委員會，證明涉案專利技術先前已由其他公司研發或在他國申請專利，故聯電與晉華指稱之涉案專利無效。

中國中央政府曾多次重申，外國企業的權益在中國會獲得公平與同等的保障。美光認為福建省福州市法院之裁決不符合中國政府所主張的政策。

美光致力於在全球積極保護和執行其商業機密和智慧產權，美光在美國加利福尼亞州對聯電和晉華提起的民事訴訟正是出於這一初衷。目前該訴訟仍在進行當中。

## 關於 Micron (簡稱“美光”)

美光為創新記憶體和儲存解決方案的領導廠商。美光的全球品牌 Micron®、Crucial® 和 Ballistix® 擁有廣泛的高性能記憶體和儲存技術產品組合，其中包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 記憶體。它們都正在改變世界使用資訊的方式，使人們的生活更豐富。以將近 40 年的技術領導地位為後盾，美光的記憶體和儲存解決方案可支援在雲端運算、數據中心、網路和行動裝置等關鍵市場領域具顛覆性的最新趨勢，包括人工智慧、機器學習和自動駕駛。美光的普通股在 NASDAQ 上市交易，其股票代碼為 MU。欲知更多美光相關資訊，請至 [www.micron.com](http://www.micron.com)。

###

*©2018 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有修改，恕不另行通知。所有資料提供係根據「現狀」處理，不提供任何形式的擔保。附圖可能未按比例繪製。Micron、Micron 標誌及所有其它 Micron 商標為 Micron Technology, Inc. 的資產。所有其他商標則為其個別持有人之財產。*

### 聯絡人

台灣媒體關係 Dora Tou <a href="mailto:dorat@micron.com">dorat@micron.com</a> +886 905 626 855	全球媒體關係 David Oro <a href="mailto:davidoro@micron.com">davidoro@micron.com</a> +1 (707) 558-8585	投資人關係 Shanye Hudson <a href="mailto:shudson@micron.com">shudson@micron.com</a> +1 (208) 492-1205
--	--	---